


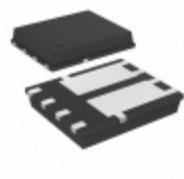



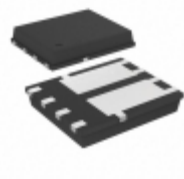

	<p><b>SI7942DP-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7942DP-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 100V 3.8A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7942DP-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6855 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7942DP-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 100V 3.8A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	6855 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.4W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	49 mOhm @ 5.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7942DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7942DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7942DP-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7942DP-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI7945DP</b> SI SI7945DP SI	 <b>SI7941DP</b> VISHAY SI7941DP VISHAY	 <b>SI7942DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 3.8A PPAK SO-8	 <b>SI7942DP</b> VISHAY SI7942DP VISHAY
 <b>SI7941DP-T1</b> VISHAY SI7941DP-T1 VISHAY	 <b>SI7941DP-T1-E3</b> VISHAY SI7941DP-T1-E3 VISHAY	 <b>SI7942DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 3.8A PPAK SO-8	 <b>SI7941DP-T1-GE3</b> Vishay SI7941DP-T1-GE3 Vishay

### heiße Teile

Mehr

SI7911DN-T1-E3	SI7911DN-T1-E3	SI7911DN-T1-GE3	SI7911DN-T1-GE3	SI7913DN-T1-E3
SI7913DN-T1-E3	SI7913DN-T1-GE3	SI7913DN-T1-GE3	SI7922DN-T1-E3	SI7922DN-T1-E3
SI7922DN-T1-GE3	SI7922DN-T1-GE3	SI7923DN-T1-E3	SI7923DN-T1-E3	SI7923DN-T1-GE3
SI7923DN-T1-GE3	SI7938DP-T1-E3	SI7938DP-T1-E3	SI7940DP	SI7940DP-T1-E3
SI7940DP-T1-E3	SI7941DP-T1-E3	SI7941DP-T1-GE3	SI7942DP	SI7942DP-T1-E3
SI7942DP-T1-GE3	SI7942DP-T1-GE3	SI7945DP-T1-E3	SI7945DP-T1-E3	SI7946DP
SI7946DP-T1-E3	SI7946DP-T1-E3	SI7948DP	SI7948DP-T1-E3	SI7949DP-T1-GE3
SI7949DP-T1-GE3	SI7956DP-T1-GE3	SI7956DP-T1-GE3	SI7958DP	SI7958DP-T1-E3
SI7958DP-T1-E3	SI7958DP-T1-GE3	SI7958DP-T1-GE3	SI7960DP-T1-E3	SI7960DP-T1-E3
SI7960DP-T1-GE3	SI7960DP-T1-GE3	SI7964DP	SI7964DP-T1-GE3	SI7964DP-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited